INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal Application No PC1/DE2004/001594

		PC1/DE	2004/001594
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L21/20 H01L33/00		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC	
	SEARCHED		
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification HO1L	on symbols)	
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in the fie	elds searched
Electronic d	ata base consulted during the International search (name of data ba	se and, where practical, search terms	used)
EPO-In	ternal, PAJ, WPI Data, INSPEC		
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Calegory °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to claim No.
A	YANG J W ET AL: "Selective area blue GaN– InGaN multiple-qualight emitting diodes over siliconsubstrates" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, Lool. 76, no. 3, 17 January 2000 (2000-01-17), page 273-275, XP012025677 ISSN: 0003-6951 page 273, right-hand column, parapage 274, left-hand column, parage 1 ————	intum well on IS, Jes	1-18
X Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are i	isted in annex.
* Special car	tegories of cited documents :	"T" later document published after the	e international filling date
"A" docume	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	or priority date and not in confile cited to understand the principle	t with the application but
	focument but nublished on or often the lettern extensi	invention	
"L" docume	in winen inda allow double off blabilly claimies) of	"X" document of particular relevance; cannot be considered novel or c involve an inventive step when t	annot be considered to he document is taken alone
citation	n or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance cannot be considered to involve	the claimed Invention
O' docume other n	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	document is combined with one ments, such combination being	or more other such docu-
P docume later th	ent published prior to the international filing date but an the priority date claimed	in the art. *A* document member of the same p	
Date of the a	actual completion of the international search	Date of mailing of the international	
	5 January 2005	02/02/2005	
Name and m	nalling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,		
	Fax: (+31-70) 340-3016	Krause, J	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intentional Application No PCT/DE2004/001594

0.40		PCT/DE2004/001594		
Category °	citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to ctaim No.		
	The second of th	ricievajii io Claiiii ivo.		
A	MIYATA NORIYUKI ET AL: "Selective growth of nanocrystalline Si dots using an ultrathin-Si-oxide/oxynitride mask" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 77, no. 11, 11 September 2000 (2000-09-11), pages 1620-1622, XP012026105 ISSN: 0003-6951 page 1620, left-hand column, paragraph 1 - page 1621, left-hand column, paragraph 2; figure 1	1-18		
A	EP 0 472 221 A2 (NEC CORPORATION) 26 February 1992 (1992-02-26) column 8, line 2 - line 41; figures 8A-8F	1-18		
A	EP 1 005 067 A2 (SONY CORPORATION) 31 May 2000 (2000-05-31) paragraph '0037! - paragraph '0053!; figures 8-13	1-18		
A	US 6 110 277 A (BRAUN ET AL) 29 August 2000 (2000-08-29) column 2, line 20 - column 3, line 27; figures 1-3	1-18		
A	EP 0 388 733 A1 (FUJITSU LIMITED) 26 September 1990 (1990-09-26) column 4, line 40 - column 6, line 58; figures 1-5	1-18		
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 676 (E-1475), 13 December 1993 (1993-12-13) -& JP 05 226781 A (FUJITSU LTD), 3 September 1993 (1993-09-03) abstract	1-18		
		_		

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2004)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Internal Application No PCT/DE2004/001594

	document search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
EP 04	72221	A2	26-02-1992	JP	2701569	B2	21-01-1998
				JP	4303982	Α	27-10-1992
				JP	4105383	Α	07-04-1992
				JP	7050815	В	31-05-1995
				DE	69115596	D1	01-02-1996
				DE	69115596	- -	19-09-1996
				DE	69128097		04-12-1997
				DE	69128097	-	26-02-1998
				EP	0643461	—	15-03-1995
	رس میں سے سی پینٹ فائٹ سے سے اسا کہ ڈ			US	5250462	A 	05-10-1993
EP 10	05067	A2	31-05-2000	JP	3470623	B2	25-11-2003
				JP	2000164988	Α	16-06-2000
				CN	1258094		28-06-2000
				KR	2000035670		26-06-2000
				SG	93850		21-01-2003
				TW	429660	-	11-04-2001
				US	6682991	B1 	27-01-2004
US 61	110277	Α	29-08-2000	DE	19715572	A1	22-10-1998
				JP	10321911	Α	04-12-1998
EP 03	388733	A1	26-09-1990	JP	2237021	Α	19-09-1990
JP 05	5226781	A	03-09-1993	NONE			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intertionales Aktenzeichen PCT/DE2004/001594

A. KLASSIF IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L21/20 H01L33/00		
Moch des les	omotionaion Data-tida-cifikation (1010 edecada) decadicación (0	offication und don 1792	
 	emationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass RCHIERTE GEBIETE	SUKABOR UND DEFILIK	
Recherchier IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymboli H01L	(e)	
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sov	weit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ame der Datenbank und evtl. verwen dete	Suchbegriffe)
EPO-In	ternal, PAJ, WPI Data, INSPEC		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		,
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	YANG J W ET AL: "Selective area blue GaN– InGaN multiple-qualight emitting diodes over silico substrates" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, UBd. 76, Nr. 3, 17. Januar 2000 (2000-01-17), Sei 273-275, XP012025677 ISSN: 0003-6951 Seite 273, rechte Spalte, Absatz 274, linke Spalte, Absatz 2; Abbi	ntum well n S, ten 2 - Seite	1-18
	itere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
Besonder "A" Veröffe aber i "E" älleres Anme "L" Veröffe schell ander soll of ausge "O" Veröffe eine i "P" Veröffe	re Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : entlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist s Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen eldedatum veröffentlicht worden ist entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung beiegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie eführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	"T' Spätere Veröffentlichung, die nach der oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bede kann allein aufgrund dieser Veröffentlierfinderischer Tätigkeit beruhend betr "Y" Veröffentlichung von besonderer Bede kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie is diese Verbindung für einen Fachrnans "&" Veröffentlichung, die Mitglied ders eibe	at worden ist und mit der ur zum Verständnis des der soder der ihr zugrundeliegenden stutung; die beanspruchte Erfindung sichung nicht als neu oder auf achtet werden sutung; die beanspruchte Erfindung keit beruhend betrachtet it einer oder mehreren anderen av Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
	Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	echerchenberichts
2	25. Januar 2005	02/02/2005	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fex: (+31–70) 340–3016	Krause, J	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internales Aktenzeichen
PCT/DE2004/001594

C./Fortoot-	und) ALS WESSNIT IOU ANDESSUENE UNITED! AOPA!	101/062	E2004/001594		
Kategorie*	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	enden Telle	Betr. Anspruch Nr.		
A	MIYATA NORIYUKI ET AL: "Selective growth of nanocrystalline Si dots using an ultrathin-Si-oxide/oxynitride mask" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 77, Nr. 11, 11. September 2000 (2000-09-11), Seiten 1620-1622, XP012026105 ISSN: 0003-6951 Seite 1620, linke Spalte, Absatz 1 - Seite 1621, linke Spalte, Absatz 2; Abbildung 1		1-18		
A	EP 0 472 221 A2 (NEC CORPORATION) 26. Februar 1992 (1992-02-26) Spalte 8, Zeile 2 - Zeile 41; Abbildungen 8A-8F		1-18		
A	EP 1 005 067 A2 (SONY CORPORATION) 31. Mai 2000 (2000-05-31) Absatz '0037! - Absatz '0053!; Abbildungen 8-13		1-18		
A	US 6 110 277 A (BRAUN ET AL) 29. August 2000 (2000-08-29) Spalte 2, Zeile 20 - Spalte 3, Zeile 27; Abbildungen 1-3		1–18		
A	EP 0 388 733 A1 (FUJITSU LIMITED) 26. September 1990 (1990-09-26) Spalte 4, Zeile 40 - Spalte 6, Zeile 58; Abbildungen 1-5		1-18		
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 017, Nr. 676 (E-1475), 13. Dezember 1993 (1993-12-13) -& JP 05 226781 A (FUJITSU LTD), 3. September 1993 (1993-09-03) Zusammenfassung		1-18		
	/ISA/210 (Fortsetzung von Blott 2) (Januar 2004)				

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichtigen, die zur selben Patentfamilie gehören

Interationales Aldenzeichen PCT/DE2004/001594

	echerchenbericht rtes Patentdokume	nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP	0472221	A2	26-02-1992	JP	2701569	B2	21-01-1998
				JP	4303982	Α	27-10-1992
				JP	4105383	Α	07-04-1992
				JP	7050815	В	31-05-1995
				DE	69115596	D1	01-02-1996
				DE	69115596	T2	19-09-1996
				DE		D1	04-12-1997
				DE		T2	26-02-1998
				EP		A2	15-03-1995
				US 	5250462 	Α	05-10-1993
EP	1005067	A2	31-05-2000	JP	3470623	B2	25-11-2003
				JP	2000164988	Α	16-06-2000
				CN	1258094	Α	28-06-2000
				KR	2000035670	Α	26-06-2000
				SG	_	A1	21-01-2003
				TW		В	11-04-2001
				US	6682991	B1	27-01-2004
US	6110277	A	29-08-2000	DE	19715572	A1	22-10-1998
				JP	10321911	Α	04-12-1998
EP	0388733	A1	26-09-1990	JP	2237021	Α	19-09-1990
JP	05226781	A	03-09-1993	KEII	VE		